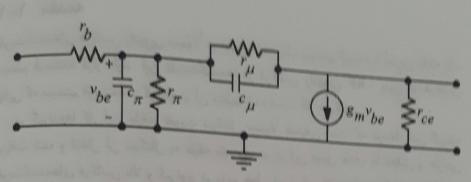
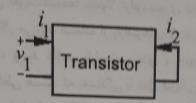
د تقوت كنده جه استال نوفك طق من لرا تس درك سيره إربوي تقوت كند عجم قراري سرد توان ريامت كده اراس كسياركم (المام عدار ن (مسكر) المام الم المره توان موهد مود سير سين ل مهر درطيع عدار أن (مسكر) سی ترد. ارطری بای عیروماب سکیری مامیت سطی توان تحویل شو توسط آست امراسی مامر ا کدورسی بهاها نرسدهی سال به توریخ کاری کی مدك تراترستورها درتقوست كسده هاى که از درل دو قعلى با راى كس تقوست كسده هاى تهم استفاده می سود مدمل وصود ۱۷۷ ی ما دارسی رتراتر لتور نطیحا ریکی موسزی ارمتها منهای رمده ماده ار ر کا مدی ترا تر تسور محلط است و حدساً م فوکائن وتقط کاروا سته اند لنادر کم طوامی مایت اندرى استفاده كرد ك درآن با إمرَ على شك از الماره كمرى مدست المده ما لله معولاً سارده منطعات ال يا إيهَ ها إ در موكاس ما و تقطي كارهاى مستف را حيار ملاح قوار مى و هد. سل ۲۱ درتراتر ستورها با نزماسی ۱۲۶ قابل سفاره اکرت (۶۴ فوطسی ۱۸ و عربان وامددر $A_{I} = \frac{ic}{iB} \quad \text{in a point of the property of the prop$ (L, = 81, V, + 8, 2/2 y, + + + + + Vz 1 L 2= YZN, + YZZN Z مدل دوقعلی ترکی لیور V, JJ11 312V2 J21V1 J22 V2



شکل 1-1 مدل π ترانزیستور دو قطبی

پارامترهای y ترانزیستورها را در این حالت میتوان به صورت زیر به دست آورد:



$$y_{ie} = \frac{i_I}{V_I}\Big|_{V = 0} \tag{1-1}$$

$$y_{fe} = \frac{i_2}{V_I} \Big|_{V_2=0}$$

$$y_{ie} = \frac{g_b[g_{\pi} + g_{\mu} + j\omega(c_{\pi} + c_{\mu})]}{g_b + g_{\pi} + g_{\mu} + j\omega(c_{\pi} + c_{\mu})}$$

$$y_{fe} = \frac{g_{m} - j\omega c_{\mu} - g_{\mu}}{1 + r_{b}[g_{\pi} + g_{\mu} + j\omega(c_{\pi} + c_{\mu})]}$$

$$\approx \frac{g_{m}}{1 + r_{b}[g_{\pi} + g_{\mu} + j\omega(c_{\pi} + c_{\mu})]}$$
(*-1)



هم چنین:

(1-1)

(5-1)

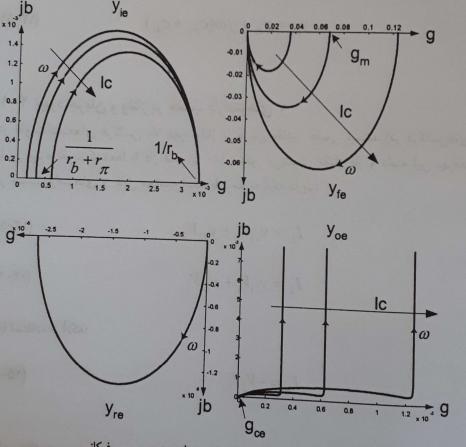
$$y_{re} = \frac{i_I}{V_2} \Big|_{V_1 = 0} \tag{(\Delta-1)}$$

$$y_{oe} = \frac{i_2}{V_2} \Big|_{V_1 = 0} \tag{5-1}$$

$$y_{re} = -g_b \frac{g_{\mu} + j\omega c_{\mu}}{g_b + g_{\pi} + g_{\mu} + j\omega(c_{\pi} + c_{\mu})}$$
 (Y-1)

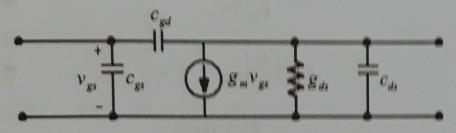
$$y_{oe} = g_{ce} + \left[1 + \frac{g_m - g_{\mu} - j\omega c_{\mu}}{g_{\mu} + g_b + g_{\pi} + j\omega(c_{\pi} + c_{\mu})}\right] (g_{\mu} + j\omega c_{\mu}) \tag{A-1}$$

نمونه تغییرات پارامترهای y ترانزیستور بر حسب فرکانس در مختصات مختلط به صورت شکل ۱-۲ است:



شکل ۲-۱ نمونه تغییرات پارامترهای y ترانزیستور بر حسب فرکانس

فر مورد ترانزیستور JFET، مدل فرکانس بالا به صورت شکل ۱-۳ قابل نمایش است:



شکل ۱ - ۳ مدل ترانزیستور اثر میدانی

$$y_i = j\omega(c_{gs} + c_{gd}) \tag{9-1}$$

$$y_f = g_m - j\omega c_{gd} \tag{(1*-1)}$$

$$y_r = -j\omega c_{gd} \tag{11-1}$$

$$y_o = g_{ds} + j\omega(c_{gd} + c_{ds}) \tag{(Y-1)}$$

y بهره جریان و ولتاژ بر حسب پارامترهای

در تقویت گننده های فرکانس بالا بهره ولتاژیا جریان مقادیر حقیقی نیستند (در فرکانسهای پایین بهره تقویت گننده ها با فاز صفریا ۱۸۰ منظور می شوند) مقدار فاز و دامنه این بهره ها بر حسب پارامترهای y قابل محاسبه است. با توجه به آنکه داریم:

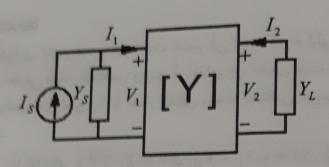
$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2 \tag{14-1}$$

$$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2 \tag{(14-1)}$$

و با استفاده از آنکه:

-V2 YL = y21 V1 + y22 V2

خواهيم داشت:



$$\frac{V_2}{V_1} = A_v = \frac{-y_{21}}{y_{22} + Y_L} \tag{18-1}$$

$$A_{I} = \frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{J_{21}V_{1} + J_{22}V_{2}}{J_{11}V_{1} + J_{12}V_{2}}$$
 : (i.i.)

$$A_{I} = \frac{I_{2}}{I_{1}} = \frac{y_{11} + y_{12} \frac{v_{2}}{v_{1}}}{y_{21} + y_{22} \frac{v_{2}}{v_{1}}}$$
(1Y-1)

و با جایگزینی رابطه (۱-۱۶) خواهیم داشت:

$$A_{I} = \frac{y_{21} Y_{L}}{y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21} + y_{11} Y_{L}}$$
 (1A-1)

ادمیتانس ورودی با استفاده از رابطه (۱-۱۹) به دست می آید:

$$y_{in} = y_{11} + y_{12} \frac{V_2}{V_1} \tag{19-1}$$

$$y_{in} = y_{11} - \frac{y_{12} y_{21}}{y_{22} + Y_L} \tag{(Y-1)}$$

به همین ترتیب ادمیتانس خروجی خواهد شد:

-Ys V= J11 V1 + J12 V2

1 = - Y5 V1 1 = - Y5 V1 2 = 321 V1 + 322 V2 1 = 302 V1 + 322 V2

Jim = 41 = 711 / + 312 /2

 $A_{v} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1}} = -\frac{\partial z_1}{\partial z_2 + \dot{y}_1}$

= -012 V2 V